

公司代码：688709

公司简称：成都华微

成都华微电子科技股份有限公司
2024 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细说明公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析 四、风险因素”。

3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

☐是 ☒否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第二届董事会第五次会议审议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.20元（含税）。截至2025年3月31日公司总股本636,847,026股，以此计算合计拟派发现金红利人民币12,736,940.52元（含税）。本次公司现金红利金额占公司2024年度合并报表归属于母公司所有者净利润的10.43%，不送红股，不进行资本公积转增股本。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

该利润分配方案尚需经公司2024年年度股东会审议通过后实施。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

☐适用 ☒不适用

第二节 公司基本情况

1、 公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	成都华微	688709	/

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李春妍	周文明、蔡进
联系地址	成都市双流区双华路 288 号	成都市双流区双华路 288 号
电话	028-85136118	028-85136118
传真	028-85187895	028-85187895
电子信箱	investors@csmc.com	investors@csmc.com

2、 报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

成都华微主要从事特种集成电路的研发、生产、检测、销售和服务，公司产品涵盖数字集成电路产品和模拟集成电路产品，其中数字集成电路包含了可编程逻辑器件（FPGA/CPLD/SoPC/RF-FPGA）、MCU/SoC/SIP 系统级芯片、存储器等，模拟集成电路包含了模数/数模转换器（AD/DA）芯片、接口和驱动电路、电源管理等，同时为客户提供 ASIC/SoC 系统芯片级解决方案。产品广泛应用于尖端技术领域，作为特种集成电路配套骨干企业，产品得到行业用户的高度认可。

1、数字集成电路产品

（1）逻辑芯片

公司的逻辑芯片类产品以可编程逻辑器件为代表，主要包括 CPLD（复杂逻辑可编程器件）、FPGA（现场可编程门阵列），SOPC（全可编程片上系统芯片）以及 RF-FPGA（集成高速 ADC/DAC 的射频直采 FPGA），具有用户可编程的特性。公司已形成完善的可编程逻辑器件产品体系，并配套全流程自主开发工具，相关产品具有非易失、小型化、高安全性等特点。目前，公司的主要产品具体情况如下：

产品大类	产品系列	产品介绍	产品图示
FPGA	奇衍系列	采用 28nmCMOS 工艺,可用门数达 7,000 万门,逻辑单元数可达约 700K,可支持 13.1Gbps	

	4V 系列	采用 65nmCMOS 工艺，可用门数最高达 2,000 万门，逻辑单元数可达约 200K	
	2V/V 系列	采用 0.13 μm -0.22 μm CMOS 工艺，可用门数覆盖百万门级区间，逻辑单元数可达约 80K	
SOPC	HWD7Z 系列	采用 28nmCMOS 工艺，集成 CPU 和 FPGA 资源，双核 CPU 主频 866MHz，逻辑单元数可达约 85K	
RF-FPGA	HWDSF 系列	采用 28nmCMOS 工艺，集成高速 ADC/DAC 和 FPGA 资源，ADC：14bit/3.2G，DAC：14bit/2.5G，逻辑单元数可达约 700K	
CPLD	HWD10M 系列	采用 55 μm CMOS 工艺，可用门数达 500 万门，逻辑单元数可达约 50K	
	HWD240/2210 等系列	采用 0.18 μm CMOS 工艺，最大容量为 2,210 个逻辑单元	
	HWD14/14XL 等系列	采用 0.18 μm CMOS 工艺，最大容量为 288 个逻辑单元	

(2) 存储芯片

公司专注于 NORFlash 及 EEPROM 存储器的研制，在环境适应性等方面具有显著优势。公司 NORFlash 存储器既可用于 FPGA 配置存储器，提供完整的可编程解决方案，亦可独立用于数据存储场景，已形成大、中、小容量三个系列产品，覆盖 512Kbit-1Gbit 等容量类型，所有产品已进入批量供货阶段。最新研制的 2Gbit 大容量产品已进入测试验证阶段。

目前，公司的主要产品具体情况如下：

产品大类	产品系列	产品介绍	产品图片
NORFlash 存储器	HWD16P/32P 系列	支持通用串行及并行接口，存储容量涵盖 512Kbit~256Mbit	
NORFlash 存储器	HWD29GL 系列	支持并行接口，存储容量涵盖 128Mbit~1Gbit，可用于 FPGA 配置存储器	
EEPROM 存储器	HWD24C 系列	支持 I2C 接口，存储容量涵盖 16Kbit~2Mbit	

(3) 微控制器芯片

公司专注于特种集成电路领域全系列 MCU 产品的研制，覆盖低功耗 MCU、通用 MCU 和高性能 MCU，主推产品 HWD32F1 系列、HWD32F4 系列和 HWD32F7 系列均已实现批量供货。基于 RISC-V 内核的低功耗 MCU 产品目前已完成流片，正在进行产品推广和客户试用。公司自主研发的 32 位高速高可靠 MCU HWD32H743，基于 32 为精简指令集内核，运行频率高达 400MHz，提供强大双精度浮点数字信号处理能力，拥有高达 2MB 的 Flash 和 512KB SRAM，在工业控制、电机控制、AIOT、机器人和智能设备等领域具有广泛应用潜力。

(4) 智能异构系统（SoC）芯片

智能异构系统（SoC）芯片融合了 CPU、GPU、NPU 以及 eFPGA 等核心 IP，实现异构多核协同处理，形成高效处理标量、矢量和张量等多种计算的灵活高效比计算平台。最新研制的 HWD109XX 系列和 HWD090XX 产品，已集成高性能 CPU、AI 加速单元 NPU、eFPGA 等组件相关产品已进入样品用户试用验证阶段。

2、模拟集成电路产品

(1) 数据转换芯片

公司瞄准国际先进水平，坚持自主正向的发展路线，针对高速 ADC/DAC 高集成度、大带宽、高线性度、低误码率、低功耗的产品发展趋势，以及高精度 ADC/DAC 超高线性度、超高温漂移偏差等要求，形成了覆盖分辨率 8~12 位、采样率 8~128GSPS 的高速 ADC/DAC 谱系化产品，采样精度 16 位及以上的高精度 ADC，12~14 位的高速高精度 ADC，12~14 位高精度 DAC 产品，部分产品达到国际先进水平，填补国内空白。为卫星通信、雷达探测、电子对抗、高端仪器仪表、工业测量、能源勘探、自动化、地震监测、数据采集系统等领域提供国内解决方案。具体情况如下：

产品 大类	产品系列	产品介绍	产品图片
高速 高精度 ADC	HWD9213 系列	产品采样率 8GSPS，分辨率 12bit，带宽达到 5GHz 以上，信噪比 $\geq 58\text{dB}$ ，无杂散动态范围 $\geq 75\text{dB}$ ，功耗 $\leq 3.0\text{W}$ ，支持 DC 耦合和多片同步，内置 DDC 模块，集成 16 对 JESD204B 标准高速接口，具有 75MeV 以上抗单粒子锁定能力和 100Krad 以上的抗总剂量辐射能力。	
超高 速 ADC	HWD08B64GA1 系列	产品是一款单通道、8 位超高速 A/D 转换器，典型采样率支持 32GSPS、40GSPS、50GSPS、64GSPS，并且可调，输入带宽支持 19GHz，误码率低至 1e^{-15} ，功耗低至 4W，抗辐照能力达到 75MeV，具备多片同步功能，集成了 32/16 对可配置的 JESD204C 高速串行接口。	
高精度 ADC	HWD976/977 等系 列	主要为 16~18 位多通道系列产品，具有工作电压高、转换精度高、功耗低的特点，采用 $0.6\mu\text{m}$ CMOS 工艺设计，采样率主要为 200Ksps，输入电压范围可达 $\pm 10\text{V}$ ，功耗范围为 85~200mW。	

超高精度 ADC	HWD1281/7710/7734 等系列	主要为 24~31 位多通道系列产品，具有转换精度高的特点，采用 0.18~0.25 μ m CMOS 工艺，采样率区间主要为 1Ksps~125Ksps，含片上增益以及偏移校准寄存器，支持系统校准。	
高速高精度 ADC	YAK12/14 等系列	主要为 12~14 位多通道系列产品，具有转换精度与速度均较高的特征，采用 28nm~0.18 μ m CMOS 工艺，采样率区间主要为 65Msps ~ 3.2Gsps，功耗范围为 290mW~2.4W。	
高精度 DAC	HWD660 等系列	主要为 12~16 位多通道系列高压产品，具有工作电压高、转换精度高的特点，采用 0.35~0.6 μ m CMOS 工艺，输出电压范围可达 ± 10 V。	

(2) 电源管理

公司专注于末级电源管理芯片的研制，主要产品包括线性电源 LDO 和开关电源 DC-DC 等。其中 LDO 为低压差线性稳压器，用于实现低压差场景下的降压转换，具有低噪声、纹波小、高精度等特征；而 DC-DC 可以实现降压、升压、升降压转换等多种功能，电压及电流适用范围更广，能够实现高转换效率。目前，公司已推出多款大电流快速瞬态响应 LDO 产品，输出电流能力全面覆盖 1A 至 5A 等多种规格，超低噪声 LDO 输出噪声指标达到 1.5 μ V_{rms}；DC-DC 已形成最高输入电压 6V~28V 的系列化产品，输出负载电流最高可达 16A。

目前，公司的主要产品具体情况如下：

产品大类	产品系列	产品介绍	产品图片
线性电源 LDO	HWD703/767 等系列	具有多通道、快速瞬态响应的特点，输出电流覆盖 1A 至 5A，具有多种输出电压模式，主要用于为数字电路器件提供输入和内核电源电压，用于输入电压和输出电压压差较低的场景下的电压调节。	
	HWD7151 系列	HWD7151 系列超低噪声高 PSRR 线性电压调整器，输入电压范围 4.5V~16V，输出电压范围 1.5V~5.1V，输出电流 800mA，输出噪声 1.6 μ V _{rms} ，电源抑制比 90 dB，用于为频率源、PLL、VCO、AD/DA 转换等对噪声敏感的模拟电路供电。	
开关电源 DC-DC	HWD46XX 系列	可实现多种场景下的降压功能，主要用于系统电能转换和传送，已形成输入电压 4.5V~16V 的系列化产品，输出负载电流最高可达 36A，可为系统提供负载点电源。	

	HWD140xx 系列	可实现高电压轨降压功能，已形成输入电压 4.5V-40V 的系列化产品，输出负载电流覆盖 0.6A~5A，可为系统提供次电源和负载点电源。	
--	-------------	---	---

(3) 总线接口

公司产品覆盖了主流串行通讯协议以及并行通讯电平转换类接口，广泛应用于系统间信号传输等领域。目前，公司的主要产品具体情况如下：

产品大类	产品系列	产品介绍	产品图片
串行通讯协议类接口	HWD3490/1490/3232/2850 等系列	具有 ESD 保护能力强、兼容多种串行协议的特点，抗静电保护范围可达±15kv，传输速率可达 30Mbps，兼容 RS485/RS422/RS232 等系列协议标准。	
并行通讯电平转换类接口	HWD16T2 45/164245/4245 等系列	具有 ESD 保护能力强、通讯速率快的特点，抗静电保护范围可达±15kv，传输速率可达 400Mbps，在系统中起到隔离及驱动的作用。	

3、集成电路检测服务

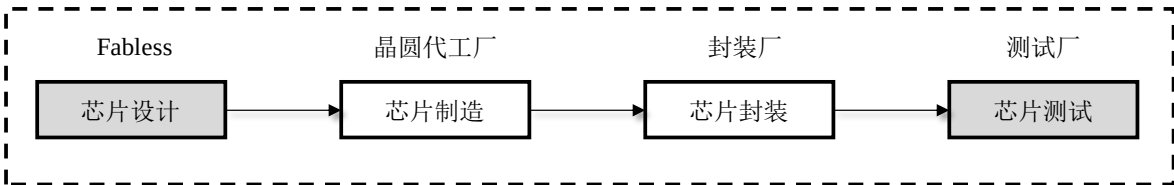
公司建立了特种集成电路检测中心，拥有综合性的公共可靠性型服务平台，专注于集成电路及分立元器件测试、可靠性试验及失效分析。检测中心拥有 600 余台（套）大规模集成电路测试系统、可靠性环境试验、失效分析仪器以及各类高精度仪器仪表设备，能涵盖 GJB597、GJB7400、GJB2438、SJ/T20668、GJB548、GJB360、GJB128 等标准的要求和试验方法，具有大规模集成电路测试开发、试验验证、失效分析和批量筛选的能力，通过 CNAS 和 DiLAC 资质认证。

检测中心已熟练掌握多种复杂集成电路和分立元器件的测试技术。其中包括超大规模可编程逻辑器件（FPGA/CPLD/SoPC）、高速高精度转换器（AD/DA）、MCU/SoC/SIP 系统级芯片、存储器、接口电路、驱动电路、电源管理、运算放大器、射频器件等集成电路，以及电阻、电容、电感、二极管、三极管、MOSFET、IGBT 等分立元器件。无论是复杂的集成电路，还是各类分立元器件，都能提供精准、高效的检测服务。

2.2 主要经营模式

1. 业务模式概述

公司采用 Fabless 模式，主要负责芯片的研发、设计与销售，晶圆加工与封装由专业的外协厂商完成。同时，由于公司产品应用于特种领域，下游客户对产品的可靠性要求较高，因此公司建立了特种集成电路检测中心，测试环节亦主要由公司自行完成。



2. 研发模式

作为一家专业的 Fabless 集成电路设计公司，产品的研发与设计是公司赖以生存的核心竞争

力。公司高度重视产品的设计与研发环节，在设计与研发方面制定了《科研任务管理制度》《科研进度管理制度》《质量评审管理制度》等完备的研发制度；设立了科学技术委员会，负责牵头公司技术发展战略及重点科研技术研究工作，指导科研项目技术方案论证、关键技术攻关，参与解决技术疑难问题，开展技术合作等对外交流工作；同时设有可编程研发中心、SoC 研发中心、转换器前沿技术研发中心、电源管理研发中心、总线接口研发中心等部门，具体负责公司相应产品的规划、研发推进、产品设计等工作，建立了完善的研发体系。

公司研发项目类型主要分为国拨研发项目及自筹研发项目两大类。国拨研发项目系公司承接国家相关主管部门研发项目，通过招投标等方式竞标取得相应项目的研发资格后，委托单位向公司提供研发资金并由公司开展研发工作，研发完成后需由相应委托单位验收成果。公司作为承研方享有技术成果专利的申请权、持有权和非专利成果的使用权，而委托方可取得该项专利和成果的普遍实施许可。自筹研发项目系公司根据市场、客户需求及自身发展规划等方面的研发需求，通过立项等内部程序后，通过自有资金开展的研发项目。

3. 采购与生产模式

公司将晶圆加工与封装交由专业的外协厂商完成，产品设计和测试环节主要由公司自行完成。因此，公司主要采购内容为晶圆及管壳等材料，封装及测试等外协加工服务，主要生产内容为集成电路的测试。根据质量管理体系的要求，公司制定了包括《供应商管理制度》《采购管理制度》《物资招标采购管理办法》等制度，有效管理采购过程中的各个环节。

4. 销售模式

公司主要采用直销模式，设置了市场总部，并下设若干销售片区，全面覆盖国内下游主流特种集成电路产品应用客户。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1) 行业发展阶段

近年来，随着国内新质生产力、数字经济的不断发展和全球人工智能浪潮下大模型和算力的迭代升级，集成电路的应用领域及市场规模均实现了高速扩张，逐渐成为全球经济的核心支柱产业之一。根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）统计，集成电路的市场规模在 2023 年达到 5,740 亿美元，其中亚太地区占据 60%~70%，是全球最大的市场板块。其中，中国作为全球最大的电子产品制造和消费体，推动了亚太地区在全球市场的主导地位。

基于不同应用领域对于产品环境适应性及质量可靠性等性能指标的需求，集成电路产品按质量等级划分，通常可分为消费级、工业级（含车规级）以及特种级，其中消费级指消费电子及家用电器等应用场景，工业级指工业控制及汽车电子等应用场景，特种级指特种领域装备的各类应用场景。随着特种电子行业国产化水平的不断提升以及各类先进技术的不断实现，特种集成电路作为电子行业重要组成部分以及功能实现的重要载体，同样有着广阔的市场前景。

(2) 行业基本特点、主要技术门槛

由于整体行业的最终应用场景及环境特征相较于其他领域更为复杂，特种集成电路对产品的性能要求更高、可靠性要求更为严格，因此在设计理念及核心技术、生产加工环节、市场准入资质等方面相较于其他领域具有显著的区别。

产品性能及可靠性需求不同。由于特种集成电路的实际应用环境特殊且复杂，对于芯片的安全性、可靠性、低功耗以及部分特殊性能（如抗震、耐腐蚀、耐极端气温、防静电）的要求相对较高，同时还需要具备较长的寿命周期。

产品设计理念及核心技术不同。特种集成电路由于需要高可靠性及安全性，因此设计需要根据不同的产品及应用环境选择合理的工艺制程。先进的工艺制程通常具有更小的晶体管尺寸，进

而带来芯片性能的提升以及面积的减小，但同时会降低电路的稳定性。由于特种集成电路应用领域多为大型装备，高可靠性相较于单纯的面积缩减更加重要，因此在芯片功能设计、性能优化的同时，更需要保障产品的可靠性。

产品生产环节不同。流片方面，特种集成电路产品由于对产品性能需求的不同，一般无法直接采用通用的标准单元库，在与工艺厂保持充分的沟通后由特种集成电路设计厂商自行设计并提供，以保障产品对稳定性和可靠性的需求。封装方面，特种集成电路应用场景可能会涉及高温、强电磁干扰、强振动、冲击、水汽、高盐雾浓度、高气密性要求等各类复杂工况条件，因此一般采用陶瓷封装或者高等级的塑料封装，必要时需安装散热板以满足芯片对特定工况条件的高可靠性需求。测试方面，特种集成电路为了保证预定用途所要求的质量和可靠性需求，所有芯片产品必须经过各种严格的环境试验、机械试验、电学实验等测试程序，包括各类功能和性能的电测试，以及针对不同鉴定检验标准的环境与可靠性试验，相较于普通工业及消费级芯片测试项目多且周期长。

市场准入资质不同。特种集成电路市场相对特殊，参与竞争存在一定的准入门槛，需要在保密体制、质量管理体系、研制许可等多方面取得相应的认证资质，并且需要进行定期的检查以及复审，对于公司的日常管理要求较高，市场准入具有一定的壁垒，竞争成本相对较高。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司作为国家“909”工程集成电路设计公司和国家首批认证的集成电路设计企业，连续承接国家“十一五”、“十二五”、“十三五”FPGA 国家科技重大专项，“十三五”高速高精度 ADC 国家科技重大专项、高速高精度 ADC 国家重点研发计划，智能异构可编程 SoC 国家重点研发计划，是国内少数几家同时承接数字和模拟集成电路国家重大专项的企业。

公司产品覆盖可编程逻辑器件（CPLD/FPGA）、数据转换（ADC/DAC）、存储芯片、总线接口、电源管理、微控制器等多系列集成电路产品，具备为客户提供集成电路综合解决方案的能力。公司建立了特种集成电路检测线，拥有中国合格评定国家认可委员会 CNAS 认证的国家级检测中心，具有较为完备的集成电路成品测试能力。经过多年的市场验证，公司的产品已得到国内特种集成电路行业下游主流厂商的认可，核心产品 CPLD/FPGA、高速高精度 ADC 以及高精度 ADC 处于国内领先地位。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1) 技术迭代推动高性能产品的不断发展

随着 5G/6G 通信、人工智能、边缘计算等新兴技术的应用，特别是特种领域愈发复杂的应用场景下对于信息准确采集及处理具有高可靠性的要求，大规模数据的快速准确获取、计算和存储能力成为集成电路产品设计的重要考虑因素之一。同时，考虑到信息处理的复杂程度、信息传输的时效性要求以及电路集成化的发展趋势，不同电子元器件间信号的高速传输、转换以及整体适配亦成为重点发展方向之一。

集成电路技术的迭代发展为高性能产品奠定了良好的技术基础。根据“摩尔定律”，集成电路上可容纳的元器件的数目，约每隔 18-24 个月便会增加一倍，性能也将提升一倍。因此，长期以来“摩尔定律”一直引领集成电路技术的发展与进步，集成电路的整体性能随着先进制程的迭代大幅提升。

在 FPGA 领域，随着先进制程迭代的推动，产品架构不断更新。本世纪初，Xilinx 和 Intel (Altera) 等公司产品的计算规模仅为数十万逻辑单元。2011 年 Xilinx 发布了基于 28nm 工艺的产品，逻辑单元达到了七千万门级，2018 年 Xilinx 发布了基于 7nm FinFET 工艺的新一代产品，逻辑单元已达十亿门级水平。在制程工艺的不断迭代中，FPGA 提高算力的同时降低了功耗，减小了芯片面积，推动了芯片整体性能的提升。

在高速高精度 ADC 领域，伴随先进工艺制程的更新迭代，产品在转换速率、信号带宽和功耗

等方面得到快速的提升，应用领域也不断扩大。本世纪初，ADI 和 TI 等知名公司大多数的高速 ADC 产品，转换速率尚为数十 MSPS 左右，仅能处理支持 GSM 的 2G 基站信号。而 2019 年 ADI 最新发布的基于 28nm 工艺的高速 ADC 产品，性能指标已经达到 12 位 10GSPS，转换速率和信号带宽处理能力都有较大提升，并且已经具备 5G 毫米波频段的信号处理能力。

（2）系统级设计及封装成为技术发展的新趋势

在 2015 年以后，集成电路制程的发展进入了瓶颈，7nm 以下制程的量产进度均落后于预期。

此外，随着器件尺寸不断减小，技术瓶颈开始显著制约工艺发展，对于整体成本和性能的提升效果亦不断削弱。集成电路行业进入了“后摩尔时代”，物理效应、功耗和经济效益成为了集成电路工艺发展瓶颈，单纯依靠制程的提升而实现性能提升已经难以实现，集成化成为了集成电路重要的技术发展趋势。

系统级芯片设计（SoC）是在一颗芯片内部集成功能不同的集成电路子模块，组合成适用于目标应用场景的一整套系统，是借助结构优化和工艺微缩等方式，采用新的器件结构和布局，进而实现不同功能的电子元件按设计组合集成。系统级芯片封装（SiP）是将不同功能的芯片和元件组装拼接在一起进行封装，封装技术的先进性将极大影响相关电路功能的实现，具有设计难度低、制造便捷和成本低等优势，使得芯片发展从一味追求高性能及低功耗转向更加务实的满足市场需求。

采用系统级芯片设计或封装，可以进一步高效地实现相关电路的高度集成化，有效地降低电子信息产品系统的开发成本，缩短开发周期，进一步实现性能、功耗、稳定性、工艺难度几方面影响因素的平衡，进一步提高产品竞争力，已经成为当前业界主要的产品开发理念和方向，在特种集成电路领域亦有广泛应用。

目前，国际主流 FPGA 芯片公司逐渐形成了在 FPGA 芯片中加入处理器的技术路线，并形成了可编程系统级芯片的新产品路线。国内同行业公司也在系统级芯片的设计方面进行了布局，如具备现场可编程功能的高性能系统集成产品（SoPC），以现场可编程技术与系统集成芯片相结合，内嵌处理器、可编程模块、高速接口及多种应用类 IP 等丰富资源；可编程器件（PSoC）产品，采用 28nm 工艺制程，内嵌大容量自有 eFPGA 模块，并配置有 APU 和多个 AI 加速引擎。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年 增减(%)	2022年
总资产	3,669,593,588.18	2,274,217,612.93	61.36	1,914,995,807.02
归属于上市公司股东 的净资产	2,809,366,206.22	1,312,814,437.45	114.00	972,362,296.40
营业收入	603,889,863.51	926,053,722.41	-34.79	844,661,250.04
归属于上市公司股东 的净利润	122,169,852.80	311,065,266.85	-60.73	281,220,444.82
归属于上市公司股东 的扣除非经常性 损益的净利润	87,616,956.37	276,671,955.49	-68.33	269,795,135.25
经营活动产生的现 金流量净额	25,464,993.83	53,736,512.48	-52.61	-1,650,919.34
加权平均净资产收 益率(%)	4.83	27.33	减少22.50个 百分点	35.98

基本每股收益（元 / 股）	0.20	0.57	-64.91	0.52
稀释每股收益（元 / 股）	0.20	0.57	-64.91	0.52
研发投入占营业收入的比例（%）	25.46	21.40	增加4.06个百分点	20.09

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	139,163,637.74	140,452,571.52	143,135,357.36	181,138,296.89
归属于上市公司股东的净利润	58,627,178.26	14,657,136.08	14,674,060.41	34,211,478.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,654,881.91	10,826,070.01	11,529,377.94	29,606,626.51
经营活动产生的现金流量净额	-46,144,539.11	31,998,405.95	-63,309,788.17	102,920,915.16

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

4、 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)						14,040	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						13,455	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）						0	
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）						0	
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记 或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
中国振华电子集团有 限公司	0	285,575,825	44.84	285,575,825	无	0	国有法人

华大半导体有限公司	0	115,707,282	18.17	115,707,282	无	0	国有法人
成都华微众志成城企业管理中心(有限合伙)	0	48,776,536	7.66	48,776,536	无	0	其他
成都创新风险投资有限公司	0	26,909,133	4.23	26,909,133	无	0	国有法人
成都华微展飞伙伴企业管理中心(有限合伙)	0	15,635,708	2.46	15,635,708	无	0	其他
中电金投控股有限公司	0	13,817,668	2.17	13,817,668	无	0	国有法人
成都华微同创共享企业管理中心(有限合伙)	0	12,850,171	2.02	12,850,171	无	0	其他
四川省国投资产托管有限责任公司	0	12,000,000	1.88	12,000,000	无	0	国有法人
成都华微共融众创企业管理中心(有限合伙)	0	9,974,703	1.57	9,974,703	无	0	其他
华泰证券资管－招商银行－华泰成都华微家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划	9,560,000	9,560,000	1.50	9,560,000	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.中国振华电子集团有限公司、华大半导体有限公司、中电金投控股有限公司均为公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司控制的企业； 2.四川发展（控股）有限责任公司间接持有四川省国投资产托管有限责任公司 100%的股权，间接持有成都创新风险投资有限公司 36.79%的股权。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

存托凭证持有人情况

☐适用 ☒不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

☐适用 ☒不适用

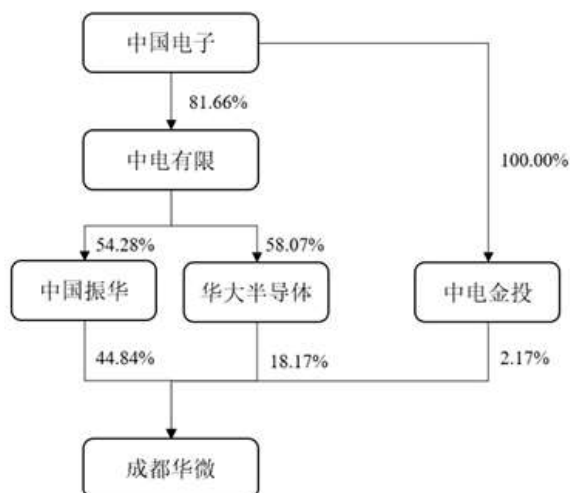
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒ 适用 ☐ 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5、公司债券情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

请参见“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

☐ 适用 ☒ 不适用